

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



Innovativity To Productivity

PRODUCTIVE TECHNOLOGIES COMPANY LIMITED

普達特科技有限公司*

(於百慕達註冊成立並於開曼群島存續之有限公司)

(股份代號：650)

半導體設備業務發展的進展

本公告由普達特科技有限公司*(「本公司」)自願作出，以向本公司股東及有意投資者提供有關本公司最新業務發展的資料。

茲提述本公司日期為二零二六年二月十一日的公告(「該公告」)，內容有關半導體設備業務的發展情況。除文義另有所指者外，本公告所用詞彙與該公告所界定者具相同涵義。

半導體LPCVD爐管設備與清洗設備通過客戶驗收

本公司一台12英寸LPCVD爐管設備成功通過客戶驗收，該設備應用於LP-SiN薄膜沉積工藝。此外，另一台12英寸ALD爐管設備在客戶端處於驗證過程中，該設備應用於ALD-SiN／ALD-SiCN薄膜沉積工藝，兼容Thermal／Plasma模式。

本公司先進半導體爐管設備產品線，擁有Galilee-LP與Galilee-ALD兩大設備平台，致力於服務12英寸邏輯制程、DRAM、3D NAND領域，應用覆蓋65nm~7nm先進節點的關鍵薄膜沉積工藝，可沉積SiN、Poly、TEOS等多種系列膜層材料，該類設備市場主要由海外供應商佔據，國產化率極低。本公司的該等設備可實現更高的填充深寬比、均勻性、台階覆蓋率與更低的污染，在先進性能指標達到國際標準的同時，擁有更高的批次生產效率，且具備多種工藝選擇的兼容性。特別地，

在先進應用開發方面，本公司已完成開發用於14/7nm節點的Low-K ALD SiOCN爐管設備，用於滿足大規模集成電路對高性能絕緣層的需求，目前該設備仍由海外設備商壟斷。

此外，本公司半導體單片清洗設備亦持續擴大客戶基礎與量產經驗。自二零二五年十月至今，已有五台6至12英吋CUBE單片清洗設備成功於多家高質量客戶處通過驗收，應用於SiC／功率器件／數模混合芯片等領域，其中兩台設備為重複訂單。該設備針對背面清洗與蝕刻工藝，具備超薄晶圓的處理能力、業界領先的伯努利傳輸與晶圓邊緣管控技術，同時通過架構創新，為客戶提供行業領先的生產力。據董事會經作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，於本公告日期，上述客戶及其最終實益擁有人為獨立於本公司及其關聯人士的第三方。

未來，本公司將繼續完成半導體先進爐管設備與清洗設備的交付與驗收，持續擴大高質量客戶基礎，並充分發揮本公司技術優勢，推動先進半導體設備國產化取得進一步突破。

一般事項

設備交付項下擬進行的交易並無構成香港聯合交易所有限公司證券上市規則第14章項下本公司的須予公佈交易。本公司將適時另行刊發公告(如需)。

股東及有意投資者於買賣本公司證券時，務請審慎行事。

承董事會命
普達特科技有限公司*
主席兼首席執行官
劉二壯

香港，二零二六年三月二十四日

本公告日期，董事會由八名董事組成，其中三名為執行董事，即劉二壯博士(主席)、譚嶠先生及劉知海先生；兩名為非執行董事，即曹霄輝先生及林鈺凱先生；及三名為獨立非執行董事，即葛艾繼女士、周承炎先生及王國平先生。

* 僅供識別